

Electroluminescent device with high power conversion efficiency - comprising anode, hole injecting zone, organic luminescent zone and cathode

Patent Assignee: EASTMAN KODAK CO Inventors: TANG C W; VANSLYKE S A

Patent Family

Patent Number	Kind	Date	Application Number	Kind	Date	Week	Type
EP 120673	A	19841003	EP 84301899	A	19840321	198440	В
JP 59194393	A	19841105	JP 8458088	A	19840326	198450	
US 4539507	Α	19850903	US 83478938	A	19830325	198538	
CA 1213662	A	19861104				198649	
EP 120673	В	19880601				198822	
DE 3471683	G	19880707			,	198828	

Priority Applications (Number Kind Date): US 83478938 A (19830325)

Cited Patents: A3...8602; EP 44686; FR 1277534; FR 1511691; FR 2111265; No search report pub.; US 3011978;

US 3162642; US 3314894; US 3491106; US 3546127

Patent Details

Patent	Kind	Language	Page	Main IPC Filing Notes	
EP 120673	Α	E	32		
Designated States (Regional): DE FR GB IT NL SE					
EP 120673	В	E			
Designated States (Regional): DE FR GB IT NL SE					

Abstract:

EP 120673 A

An electroluminescent device with a power conversion efficiency of at least 9 x 10 power - 5 w/w, comprises (in sequence) an anode electrode; a hole-injecting zone; an organic luminescent zone; the zones having a combined thickness of not more than 1 micron; and a cathode electrode; at least one of the electrodes being capable of transmitting at least 80 % of radiation having wavelengths longer than 400 nm.

Pref. the luminescent zone comprises an electron-transporting cpd. that provides a max. electroluminescent quantum efficiency of at least 5 x 10 power -4 photons/electron when used in a test driven at no more than the lesser of (i) 25 volts and (ii) the voltage which produces the max. power conversion efficiency of the device, the test device comprising (1) a hole-injecting zone comprising 1,1-his(4-di-p-tolylaminophenyl)cyclohexane, (I) and the hole injecting zone and luminescent zone having a combined thickness of no more than 1 micron, (2) an anode electrode that transmits at least 80 % of radiation having wavelengths longer than 400 nm, and (3) an indium cathode. The electron-transporting cpd. is pref. a specified optical brightener.

ADVANTAGE - The EL devices have high power conversion efficiency and can be operated at a driving voltage of

http://toolkit.dialog.com/intranet/cgi/present?STYLE=1360084482&PRESENT=DB=351,AN=4099649,... 11/26/2002

Laws Kesuns

not inore than 25 volts.

EP 120673 B

An electroluminescent device with a power conversion efficiency of at least 9 x 10 power - 5 w/w, comprises (in sequence) an anode electrode; a hole-injecting zone; an organic luminescent zone; the zones having a combined hickness of not more than 1 micron; and a cathode electrode; at least one of the electrodes being capable of ransmitting at least 80 % of radiation having wavelengths longer than 400 nm.

Pref. the luminescent zone comprises an electron-transporting cpd. that provides a max. electroluminescent quantum efficiency of at least 5 x 10 power -4 photons/electron when used in a test driven at no more than the lesser of (i) 25 volts and (ii) the voltage which produces the max. power conversion efficiency of the device, the test device comprising (1) a hole-injecting zone comprising 1,1-his(4-di-p-tolylaminophenyl)cyclohexane, (I) and the hole njecting zone and luminescent zone having a combined thickness of no more than 1 micron, (2) an anode electrode hat transmits at least 80 % of radiation having wavelengths longer than 400 nm, and (3) an indium cathode. The electron-transporting cpd. is pref. a specified optical brightener.

ADVANTAGE - The EL devices have high power conversion efficiency and can be operated at a driving voltage of not more than 25 volts.

Dwg.1/2

US 4539507 A

Electroluminescent device comprises in sequence, anode electrode, hole injecting zone, organic luminescent zone and tathode electrode.

At least one electrode can transmit at least 80% of radiation of wavelength above 400 nm.

The luminescent zone comprises an electron transporting cpd. providing max. electroluminescent quantum efficiency of at least 5x10 power-4 photons/electron, when used in a test device at 25V

or, if lower, the voltage which produces max. power conversion efficiency.

The test device has (2) a

iole-injecting zone consisting of 1,1-bis-(di-p-tolylaminophenyl) cyclohexane with the hole injecting zone and uminescent zone

naving total thickness up to 1 micron, (2) anode electrode

ransmitting at least 80% of radiation of wavelength over 400 nm and (3) indium cathode.

ADVANTAGE - The device has power conversion efficiency at least 9x10 power-5 w/w and the zones have combined hickness of at most 1 micron.

12pp)

Derwent World Patents Index

3 2002 Derwent Information Ltd. All rights reserved.
Dialog® File Number 351 Accession Number 4099649

attp://toolkit.dialog.com/intranet/cgi/present?STYLE=1360084482&PRESENT=DB=351,AN=4099649,... 11/26/2002

(9) 日本国特許庁 (JP)

[®] 公開特許公報(A)

① 特許出願公開

昭59-194393

⑤Int. Cl.³H 05 B 33/14// C 09 K 11/06

識別記号

庁内整理番号 7254-3K 7215-4H 砂公開 昭和59年(1984)11月5日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 12 頁)

図改良された電力転換効率をもつ有機エレクトロルミネツセント装置

②特 願 昭59-58088

②出 願 昭59(1984)3月26日

優先権主張 Ø1983年 3 月25日 Ø米国(US)

@478938

②発 明 者 スチーブン・アーランド・バン スリク

アメリカ合衆国ニューヨーク州 14613ロチエスター市ピアーポ

ント・ストリート324

②発 明 者 チャン・ウオン・タン

アメリカ合衆国ニユーヨーク州 14626ロチエスター市パーモン ト・ドライブ197

⑦出 願 人 イーストマン・コダック・カン

アメリカ合衆国ニューヨーク州 14650ロチェスター市ステート ストリート343

個代 理 人 弁理士 湯浅恭三 外 4 名

明 細 響

1. [発明の名称]

改良された電力転換効率をもつ有機エレク トロルミネッセント装置

2. [特許請求の範囲]

順 次陽便、正孔インジェクション 帯域、有機 発光帯域 (これらの帯域を合わせた厚さは 1μm を越えない)、 および路板からなり、

これらの電極のりち少なくとも一方は400 nm 以上の皮長をもつ輻射線の少なくとも80%を 透過させるととができ、かつ

少なくとも9×10 W/W の電力転換効率を もつエレクトロルミネッセント接近。

3. (発明の詳細な説明)

本発明は、有機化合物を発光手段とする、 概 気信号に応答して発光するエレクトロルミネン セント袋底に切する。

有機エレクトロルミネッセント装置がそれらの対抗品と十分に対抗しりるものとなるためには、対抗しりるコストにかいてそれらの電力転

野幼稚圧を25ポルト以下に低下させるためには薄膜型エレクトロルミネッセント 装置が設ましい。これはここでは有効な希望された性質の厚さ、 すなわち電板間にある効質の厚さが 1μm を選えない装置を意味する。 ピンホールの問題を考えると薄膜の形態を達成することは特に困難であった。 ピンホールは魔地をショートさせ

るので受入れられない。たとえばドレスナー、 RCAレビュー、Vol. 30. 322ff 頁 ・ (1969年6月)、 特代326頁を参照され たい。ピンホールの形成を防止するために、被 復用配合物中に結合剤を使用することが好都合 とされている。この顔の結合剤の例には付加重 合体たとえばポリスチレン。および紹合重合体 たとえばポリエステルが含まれる。 猛乱のショ - トは避けられるが、結合剤を使用することは 不満足な場合がある。とのためには密剤被緩加 工法を用いる必要があり、ある層の格削は下層 の溶剤としても作用する可能性があり、これに より厳酷の明瞭な境界設定が妨げられる。結合 剤を必要とする 1 暗を溶剤被覆したのち結合剤 を必要としない暗(1暗または多層)を蒸着さ せる方法は考えられるが、逆の順序すなわち発 光層を紹削被覆する場合。密削が下層に影響を 与えた場合の実用性は証明されていない。

米国有許明 4,3 5 6,4 2 9 号明細智に記載された載也は、正孔インジエクション帝域

わせた厚さは 1 um を越えない)。および陰篠 からなり。

これらの電優のうち少なくとも一方は400 nm 以上の皮長をもつ輻射線の少なくとも80%を 透過させることができ、かつ

少なくとも 9×10 W/W の電力転換効率をも つエレクトロルミネッセント装置が提供される。

件ましくはこの毎個の発光帝域は、i)25 ボルト以下かよびi) この毎職の最大限力伝験効果を与える電圧以下で駆動される試験毎職に用いた場合、少なくとも5×10 光子/ 選子のエンクトロルミネッセント電子効果をはは11 本で、シクトロルミネッセント電子効果をはは11 本で、おいて、11-ビス(4-ジーアートリルアミノフェール)シクロへキサンからなるクレーシン帝域(この正孔インジェクション帝域(この正孔インジェクション帝域を合わせた噂さは1 4m を終れていり、21 400 nm 以上の波長をもつ編射の少なくとも80 多を透過させる勝柄、およ

(hole injecting zone)としてポルフィリン系化合物からなる層をもつ本発明のものと同し型の鉄喰の一例である。

上記符件のセルは先行技術のセルよりも著しい改良を示したが、望まれている電力転像効率、すなわち25ポルトを超えない脳動戦圧を用いた場合に少なくとも9×10 W/W の水準を選びしていない。正孔インジェクション層内のポルフィリン系化合物は有色であるため、セルにより放出される光を若干吸収するという望ましくない傾向を示す。またポルフィリン系化合物は有効に発光するために必要な正孔かよび電子の有効な発光的再結合を妨げると思われる。

本発明の目的は、少なくとも1桁改良された、 すなわち少なくとも9×10 W/W に及ぶ進力 転換効率をもつエレクトロルミネッセント(以 下 EL") 装値を提供することである。

本発明によれば、順次陽福、正孔インジェク ション帝城、有機発光帝城 (これらの帝城を合

びる)インジウム製除極から構成される。

本発明の毎世は必要とされる改良された電力 転換効率を示す。

本発明の接触において発光帝域または正孔インジェクション帝域はそれぞれ電子伝達化合物からまたは正孔伝達化合物から作成され、これは本発明の実施取様の多くにおいてそれぞれの帝域に結合剤を用いずに行われる。

本発明のさらに他の有利な特色は、正孔イン ジェクション勝用として、 発せられた輻射線に 対し実質的に透過性である化合物が見出された ことである。

本発明の他の有利な特色は添付の図面を考慮 に入れて後記の好ましい実施製録を参照するこ とにより明らかになるであろう。 専1図は電源 に接続した本発明接踵の一部の概略的断面図で あり、

第2図は本発明に従って製造された装置に導する 電力転換効率対エレクトロルミネツセント 世子効率を示す対数一対数グラフである。

正孔インジェクション物質および発光物質は 各帯域内に存在する(この帯域が離であっても 他のものであっても)。 好ましいエレクトロル ミネンセント 接踵においてこれらの物質は顕次 重なった被膜ないしは順中に存在する。

正化インジェクション悩は正代伝達化合物からなり、一方発光増は並子伝達化合物からなる。本籍明者らは、後記のように駆動かよび構成されるセルに用いた場合に5×10⁴光子/電子を軽えるEし前子効果を与える特定の電力を換効器と化合物があることを見出した。電力を換効器ととしま子効果の間には直接的な蝴蝶があるので、関して電力を換効率は少なくとも9×10⁵W/Wとなるととが保証される。これらの化合物は容易に導質の形態で洗着するので、有効符域を合わせた厚さが1μmを軽えない薄膜型医臓が容易に得られる。

本発明の装置に用いられる電子伝導化合物は、 電化量元反応において満元されりる化合物であ

動電圧をかけ、最大電子転換効率または25 ポルトのいずれかに進するまで (いずれが先に起 とるとしても)高める。この電圧にかいて較大 EL電子効率を測定する。

表)には、上記のように構成され、かつ上記の電圧で駆動される装置において試験した場合の若干の有用な電子伝達化合物に関するEL量子効率を示す。とれらの例のそれぞれにつき、最大EL最子効率の電圧は25ポルトの制限以下であった。

る。本発明において特に有用なものは、前配の 試験に関して少なくとも 5×1 0 E L 妻子効率 を与える電子伝達化合物である。 周知のように E L 妻子効率は単純に外和回路で側定される電 子/秒に対する、セルから放出される光子/秒 の比に等しい。 この効率を電力転換効器(W/W の単位で定義される) と旗同してはならない。

電子伝達化合物が少なくとも5×10 光子/電子(オなわち0.05%)のEL電子効果を与えるか否かを判定するためには下配の試験を行う。

Eしせんは下記の順序で構成される:
400nm以上の波長をもつ朝射線の少なくとも80まを透過させる陽便[たとえばネザトロン(Nesatron、商標)ガラス];本質的に1,1-ビス(4-ジーp-トリルアミノフェニル)シクロヘキサンからなる正孔インジェクション層;問題の電子伝達化合物の層; およびインジウム製管板。ことで正孔インジェクション階と発光増は合わせて厚さ14を鍵えない。
数

御家点な対え	1 8 V	2 0 V	2 0 V	15 V	125 V	2 4 V	1 5 V	1 4 V	
	2×10	1×10*	8×10	3×10 ⁴	3×10³	1.5 × 10	5×10*	8×10	
. 45	ロン路径/エピンドロジャン500Å1/インジウェ(1n)緑橋	(孔数 色) 。 o 200億/HI-1 (V2nm)/E1 7 n: f: / 1: 44 fi	7.0mm//1.mga a/26/HI-1(75nm)/E2 75-1-1/1-196	・June - / June 6 ロン部第/出 I - J (V2 nm) / 10.3 フェーン / Jine 8	- 7 mm - 7 mm m	7.0mm/1mm的 5.0mm/HI-1(75nm)/ES 75nm/7mm/Tmm/meth	高い	7 2 mm / 1 mm m r r x 2 mm / 1 1 1 1 2 mm / E 7 7 2 mm / I mm mm	

* * * * * *

E 5を徐いて有効数子 1個に四档五入した。

2 H I - 1 = 1,1 - ピス(4・ジ・p - トリルアミノフェニル)ンクロヘキサン

[4,4'- ピス [5,7 - ジt - ベンナル - 2 - ベンゾキサゾリル] スチルベン]

. [25-ビス[57-ジーtーベンチルー2ーベングキサゾリル]チオフェン]

(2,2'-(1,4-フェレンジピニレン)ピスペングデアゾール]

6 E4=

[2,2'-(4,4'-ピフェニレン)ピスペングチアゾール]

7 E5= ピス(8-ヒドロキシキノリノ)マグネシウム

[2,5~ビス[5~(α,α~ジメチルベンジル)~2~ベンゾキサゾリル]チオフェン]

(2,5-ビス(5,7・ジ・ビーペンチル・2・ペンジャサンリル)-3,4 - ジフェニルチオフエン)

より好ましくは、正孔インジェクション暗は本質的に無色である。これは陽極に腰接した位 酸にあり、陽徳は透明な 単極であることが好ましい。従って正孔伝達化合物も400nm 以上の放長にかいて少なくとも90%透過性であることが好ましい。

前記の光透過性をもつ有用な正孔伝達化合物 の好ましい例には、室温で固体であり、かつ少 なくとも1個の容素原子が厳機器でトリ腹機さ れた(そのうち少なくとも1個はアリール基または憧憬アリール基である)アミンが含まれる。アリール基上の有用な憧憬基の例には、1~5個の炭ス原子をもつアルキル基、たとえばメチル基、エテル基、プロピル基、プチル基かよびアミル基:ハロゲン原子、たとえば塩ス原子かよびフッス原子:ならびに1~5個の炭ス原子を有するアルコキン基、たとえばメトキン基、エトキン基、プロポキン基、プチル基かよびアミル基である。

本発明に用いられる正礼伝達化合物のあるもの、かよび電子伝達化合物のあるものは、 神膜形成性化合物であるという付加的な性質をもつことが注目される。ここで用いられるようにある化合物がこの物質を破板などの支持体上に 0.5 μπ 以下の厚さで施した場合に " 薄膜形成性 " である場合。これは異質的にピンホールを含まない確を形成する。しかしある化合物が薄膜形成性であるということは必ずしも0.5 μπ よりも多数に存在しないということを意味する

わけではない。有効帯域の一方の層がこの機の 体験形成性化合物である場合。両層にかいて結 合剤を称くことができるという点でこの解膜形 成性は有用である。従って本発明の一実施懇様 にかいては、発光層かよび正孔インジェクショ ン帯域の双方が結合剤を含有しない。

あるいは他の場合には正孔と覚子の発光的再 結合を妨げない結合剤も本発明に有用である。

前記のように構成を形成しりる化合物の有用な例を以下に示す。有に有用な例には複葉環もしくは炭素環、およびる個以上の炭素原子を有する脂肪族類少なくとも2個を含有するか、あるいは少なくとも2個の基でなわちそれぞれ。)一直結合の囲りに回転しりる基および。)少なくとも3個の芳香族もしくは危和炭素資を含む場を含有する化合物が含まれる。

たとえば穆陂形成性である正孔伝達化合物に は次式の柳嶺をもつものが含まれる。

1,1 - ピスし4- ジ- p - トリルアミノフェニル)ンクロヘキサン;および次式の構造をもつ化合物

(上記式中nは2~4の整数である)、たと允は4.4-ビス(ジフェニルアミノ)クワドリフ

さらに他の有用な正礼伝達化合物には米国等許年4.175,960号明細書13個13行から14個42行に列挙されたもの。たとえばビス(4-ジメチルアミノ-2-メチルフェニル)フェニルメタンおよびN、N、N-トリ(p-トリル)アミンが含まれる。

薄膜形成性の電子伝達化合物に関しては、好ましい例には愛光増白剤が含まれる。最も好ましいものは次式の構造をもつ祭光増白剤である。

これらの式中 R'. R'. R'. および R* は別個化水 気原子;1~10個の炭素原子を有する飽和脂 肪族残基、たとえばプロピル基、 t - プチル基 およびヘブチル基:6~10個の炭素原子を有 するアリール基、たとえばフェニルをおよびナ フチル基:あるいはハロゲン原子、たとえば R* ま原子およびフッ衆原子であるか;あるいはR* と R*、または R*と R* が一緒になって、1~ 10個の炭素原子を有する飽和脂肪族 援基(た と えばメチル基、エチル基およびプロピル基) 少なくとも1個を含んでいてもよい縮合芳香族 切を完成するために必要な原子を明成し、

R³は 1 ~ 2 ① 個の炭素原子を有する飽和脂肪族 残務。たとえばメチル基、エチル基かよびn‐ T1コシル基:6 ~ 1 ① 個の炭素原子を有する Tリール値。たとえばフェニル基かよびナフチ ル基:カルボキシル基:水素原子:シアノ基: あるいはハロゲン原子、たとえば塩素原子かよ びフッ素原子であり:ただし式 c) にかいて R³、R⁴ かよび R³のうち少なくとも 2 個はる~ 10個の炭素原子を有する飽和脂肪族残蓄、た とえばプロビル番、プチル基またはベプチル基 であり、

Zは-O-. -NH-または-S- であり; Yは-R*+CH=CH+_R*-.

mは0~4の整数であり;

nは0.1.2または3であり;

R* は6~10個の炭素原子を有するアリーレン基、たとえばフェニレン基かよびナフチレン基であり:

R' は水果原子または6~10個の炭素原子を 有するブリール基であり: そして Z'シよび Z' は別個にNまたはCH である。

上記の脂肪族幾基は酸與されていてもよい。産

換された脂肪族機器の場合の世換器には、1~5個の炭素原子を有するアルキル基。たとえばメチル基、エチル基かよびプロピル基:6~10個の炭素原子を有するアリール基、たとえばフェニル基およびナフチル基;ハロゲン原子、たとえば塩α原子かよびフン素原子:ニトロ老:ならびに1~5個の炭素原子を有するアルコキン芸、たとえばメトキン基、エトキン基およびプロポャン基が含まれる。

特に好ましい盤光増白剤の例には下記のものが含まれる。2.5 - ピス(5,7 - ジー t - ペンテル・2 - ペンゾキサゾリル) - 1,3.4 - チアジアゾール;4.4-ピス(5,7 - t - ペンチル・2 - ペンゾキサゾリル) スチルペン;2.5 - ピス(5,7 - ジーt - ペンチル・2 - ペンゾキサゾリル) チオフェン;2.2-(p - フェニレンジピニレン) - ピスペンゾチサゾリル) ピフェニル;2.5 - ピス(2 - ペンゾキサゾリル) ピフェニル;2.5 - ピス[5 - (a 。 σ - ジメチルペンジル) - 2 - ペンゾキサゾリル] チオフェン;4.4-

ピス (5,7 - ジー (2 - メチル - 2 - ブチル)
- 2 - ベンゾキサゾリル] スチルベン: および
2,5 - ピス (5,7 - ジー (2 - メチル - 2 - ブ
チル) - 2 - ベンゾキサゾリル] - 3,4 - ジフ
ェニルチオフェン。

さらに他の有用な簡光増白剤はケミストリー・オブ・シンセティック・ダイズ、1971、628~637頁かよび640頁に列挙されている。すでに複膜形成性ではないものは、一端または両端の関に脂肪族の基を結合させることによって複膜形成性にすることができる。この種のさらに有用な観光増白剤には、たとえば下紀のものが含まれる。

〔2-{2-〔4-ℓ2-ベンソイミダソリル〕 フェニル〕ビニルトベンソイミダソール〕

[5-メチル-2-[2-[4-15-メチル-2-ベングキサグリル]フェニル]ビニル] ベングキサグ - ル]

[2,5 - ピス(5 - メテル - 2 - ペンソギサゾ リルトチオフェン]

[2-[2-14-カルボキシフェニル]ビニル]ベンゾイミダゾール] および

さらに他の有用な博饃形成性の電子伝達化合物には8-ヒドロキシャノリンの金属錯体が含まれ、その際金属は好ましくは2n. Ag. Mg またはLi である。

有効協の一方が複製形で性である場合、各易に認められるようにピンホールのため装置がショートするととはないので、他方は薄膜形で性である必要はない。たとえば有用な装置は、前配の海膜形の性化合物からなる正孔インジェクション層、および薄膜形で性でない化合物、たとえば1,1,4,4-テトラフェニルー1,5-プタジエンからなる発光値を含む。

前紀の数しから明らかなように、有用な帰獲 単穏には脳師『オザトロン』のもとにPPG1

ンダストリーズ社から得られる被覆ガラス陽極 が含まれ、有用な陽循環極にはインジウムが含 される。一般のいかなる関係および陰極もそれ が適切な仕事観效額をもつならは使用できる。 たとえば陽後は高い仕事與数をもつべきである。 他の有用な隣値の例にはいずれかの半透明な高 い仕事場政をもつ導躍性材料。たとえば酸化ス ズインジウム、酸化スズ、ニッケルまたは金で 被覆したガラスが含まれる。好ましくは、この 後の陽極は10~1000オームノスクエアー (ohms/square)のシート抵抗、および400 nm 以上の放送に対し30%の光透過塩をもつ。 このように高い光透過名を少なくとも90まと いう正凡伝達化合物の透過塞と合わせた場合に、 本発明に従って作成された装置の背色である卓 越した魅力伝染効率が保証される。

他の有用な陰核の例には低い仕事関数をもつ 他の金属、たとえば銀、スズ、鉛、マグネンウム、マンガンおよびアルミニウムが含まれる。 金属が存置により発生するルミネンセンスに対 して高い透過事をもつか否かは隣係ない。

明1図は本発明に従って製造されたエレクトロルミネッセント 装置を示す。 これは酸化スズインジウムの半透明被膜16で被覆されたガラス製支持体14からなる陽極12を含む。 この上に正孔インジェクション増18が配置される。 層18かよび20の一方または双方が薄膜形成性化合物である。 陰極22は確20上に配置され、リートワイヤ24が装置を超頭26に接続する。 電18と20の界面へ伝達され、ここで陰極22から伝達された電子と結合し、可視光線hレを発する。

電源 26 が装置 10 の最大出力点の電圧たと えば $15\sim25$ ポルトで操作される場合、最大 電力転換効率は少なくとも 9×10^{-3} W/W である。ある場合にはこの効率が 2×10^{-3} に及ぶこ とが認められた。本発明の装置は改良された電 力転換効率の結果 1700 cd/ π (500 フィー

トランベルト)に及ぶ最大輝度を生じることが 認められた。

本発明のEL接触は常法により作成される。 すなわち正礼インジェクション層、発光層かよび陰値をそれぞれ密蔽被覆法または蒸発により 施す。正孔インジェクション層が最初に形成されることが好ましい。発光層に有用を密剤が正 礼インジェクション層に対しても良好な密剤で ある場合、発光層を形成するためには蒸発が好 ましい。ここで明いられる"蒸発"には蒸気が好 ましい。ここで明いられる"蒸発"には蒸気が好 すりのむ着のあらゆる形態が含まれ、真空下で 行われるものも含まれる。

下記の実施別により本発明をさらに説明する。 これらの実施例において最大輝度は不可逆的破壊を生じる は圧のすぐ下の間圧で制定される。 若干の実施別において駆動間圧について25V という好ましい限度を越える緑曜に関するほに が示されているのはこのためである。

夹施例1

毎1図のものと類似したエレクトロルミネッ

セント袋屋(以下"セル")を以下により製造 した。

1) 陽便を作成するため、オザトロンガラスをまず 0.05 Am アルミナの研解材で数分間研離した、次いでイソブロピルアルコールかよび蒸留水の1:1 (M)混合物中で超音波清浄した。次いでこれをイソプロピルアルコールですすぎ、窒累で送風乾燥させた。最後に、使用削にこれをトルエン中で超音波清浄し、窒累で送風乾燥させた。

21 1,1 - ピス(4 - ジ - p - トリルアミノフェニル)シクロヘキサン(HI-1)をネザトロンガラス上に一般的な真空蒸溜症により沈溜させた。すなわち上記物質を選気的に加熱されたタンタル製ポートから320℃の属板で5×10³トルの系内圧力にかいて蒸発させた。ネザトロンガラスに沈着した生成HI-1フィルムの厚さは75nm であった。

3) 次いで4,4'-ピス(5,7 - ジーt-ベンチル-2 - ペンゾキサゾリル)スチルペン(E1)

4) 次いてインジウムをE1フィルムの上部に シャドーマスクを介して比解させた。 In 単極 の面積はQ1cmであり、これもエレクトロルミ ネッセントセルの有効面積を規定した。

出来上がったセルはオザトロンガラス電復をフラスとしてパイアスをかけた場合、育緑色の光を放出した。放出された光は520 nm 化最大放出を有していた。遅成された最大輝電は与えられた健圧が22Vである場合、電流密電140mA/cdにおいて340cd/m であった。20Vで配動した場合、最大電力転換効率は1.4×10³W/W であり、最大エレクトロルミオンセント養子効率は1.2×10⁴光子/電子であった。

舆施例2

傳膜形成性でない正孔インジェクション層の

20 ポルトで駆動した場合、最大電力転換効率 は8.1×10 W/W であり、最大EL電子効 客は6.9×10 光子/量子であった。

これらの結果は、発光層が薄膜形成性化合物 からなるためピンホールを含まないならば正孔 インジェクション値は薄膜形成性でなくてもよ く、また結合剤を含有しなくてもよいことを証 明している。

実施例3

発光順用の他の物質

実施例1と同様化してエレクトロルミネンセントセルを製造した。ただし下記の鉄光増白剤を発光階として用いた。

[2,5 - ピス (5,7 - ジ - t - ペンチル - 2 -ベンゾヰサゾリル) - 1,3,4 - チアジアゾ - ル] 使用

実施例1に記載したようにエレクトロルミネンセントセルを製造した。ただしN.N.N-トリ(p-トリル)アミンを正孔インジエクション層としてHI-1の代わりに使用した。このアミンは次式の構造をもつ。

セルは実施例1に記載したものと同じ方法で 製造された。ただしアミン蒸発のための供給源 温度は120℃であった。厚さは $75\,\mathrm{nm}$ であった。とのセルに $30\,\mathrm{V}$ をかけた場合、 電流密 度 $40\,\mathrm{mA/cd}$ かよび最大輝度 $102\,\mathrm{cd/m}^2$ が 得られた。放出された光はこの場合も常緑色で あり、 $520\,\mathrm{nm}$ に最大放出を有していた。

実施例1と同様にしてもルを製造した。ただし盤光増白剤の蒸発のための供給原温度は260でであった。放出された光は程色であり、590nm に般大放出を有していた。 得られた最大輝度は30 V かよび40 mA/cdにかいて340cd/mであった。20 V で駆動された場合、最大電力転換効率は1.5×10 W/W であり、最大EL量子効率は1.4×10 光子/妻子であった。

発光層用の他の物質

実施例1と同様にしてエレクトロルミネッセントセルを製造した。ただし2.2-(p-フェニレンジビニレン)ビスペンンチアン・ル(E3)を発光備として用い、300℃で蒸発させた。

E 3

とのセル(ネザトロン/HI-1/E3/In)

は緑色の光を放出し、これは560nm に最大 放出を有していた。得られた最大輝度は1.7.5V かよび200 mA/cd にかいて340 cd/m で あった。15 V で駆動した場合、最大電力転換 効率は 4×10^4 W/W であり、最大エレクトロ ルミネッセント量子効率は 3×10^3 光子/量子 であった。

实施例5

発光階用の他の物質

前記実施例1と同様化してエレクトロルミネンセントセルを製造した。ただし2-(4-ビフェニル)-6-フェニルペンジャサゾール(PBBO)を発光値としてE1の代わりに用い、200でで蒸発させた。

とのせん(オザトロン/HI-1/P8BO/In)は白青色の光を放出した。得られた最大母壁は25Vかよび50mA/cd にかいて34cd/㎡であった。20Vで駆動した場合、最大電力伝染効率は9.5×10 W/W であり、最大エレクトロルミネッセント電子効率は8×10 光子/電子であった。

突施るおよび7

発光層用の他の物質

突施例1と同様にしてエレクトロルミネッセントセルを製造した。ただし発光晦は E 1の代わりに 2.5 - ビス [5 - (a . a - ジメチルペンジル) - 2 - ペンゾキサゾリル] チオフエン(実施例 6 1 および 2.5 - ビス [5.7 - ジー t - ペンチルー 2 - ペンゾキサゾリル] - 3.4 - ジフェニルチオフェンからなり。 3 4 0 ℃の温度で蒸発させた。 表』に結果を示す。

•	の発送の で で で で が	15v	144
	微大 BC ▲子勢略	5×10。 養子/義子	1.4×10 84×10 W/W 数子/電子
I.	機 関の を 関わ の の の の の の の の の の の の の の の の の の	7×10° W/W	1,4×10 W/W
₩	煅煤 大 冤	680cd/m² (19V±LC 150mA/cm² 'K±WJ]	1700cd/m' (20vb.tg 300mA/cd K&w.T)
	成故	530 am	•
•	€0	欜 .	•
	路路	9	~

奥施贸8

薄膜形成性でない電子伝達化合物

実施別1と同様にしてエレクトロルミネツセントセルを製造した。ただし、1,1,4,4 - テトラフェニル - 1,3 - ブタジエン(TPB)を発光層として用いた。

TPB昇輩のための供給領温販は210℃であった。このセルは育色の光を放出し、これは450nm に最大放出を有していた。得られた球壁は20Vかよび200mA/cm にかいて102cd/m であった。15Vで駆動した場合、最大電力転換効率は2×10 W/W であり、最大エレクトロルミネッセント量子効率は1.2×10 光子/量子であった。このセルは蒸発したTPB

階の不均便なかつ薄膜形似性でない性質にもかかわらず機能した。TPB層は顕敬競下で見た場合小さなクラスターのモザイクの外膜を有していた。

奥施例タンよび10

電子伝達化合物として8 - ヒドロキシキノリグ の金減錯体を便用

実施例 1 と同様にしてエレクトロルミネッセントセルを製造した。ただしビス(3 - ヒドロキシャノリノ) アルミニウム(実施例 9)、 および次式

	部を	15V 24V
	表 大 图 L L D S L	5.8×10³ 15V 光子/電子 1.5×10³ 2.4V 光子/電子
	表 大商品 力高級的報	82×10*
嵌	表 課 (10 p c)	340 (15V±LU 50mA/cd (C±N·T) 340 (24V±LU 100mA/cd (C±V·T)
	数田数田なれなれるの数のの数数をを数を	泰 515nm 赖 548nm
	数田政政化の政策の政策	碳
	海路	6 0 0

の構造をもつビス(8~ヒドロキシキノリノ)マグネシウムをそれぞれ発光値として用いた。 操作条件は実施例1の配数と同様であった。ただし金銭錯体の供給液温度はそれぞれ330℃(実施例9)および410℃(実施例10)であった。装置に結果を示す。

上配各実施例に示した効率を便宜のため第2 図にプロットした。第2図の点線は傾向を示す にてぎず、いずれかの方法による最適なものを 表わすものではない。そこに示されたデータは 収保式

fog(電力転換効率)=fog(EL量子効率)+fog K (上記式中Kは切片(intercept) であり、 医動電圧によって一部制御される係数である) に従うとほぼ直線状である。駆動電圧(第1図 の財源26)の値が上がるのに伴って、第2図 の曲線は下方へ移動する。従ってより高い駆動 電圧では、同一のEL量子効率でも、もはや希望する9×10W/W の難力転換効率を与えないようになるであろう。

4. [図面の簡単な説明]

毎1 図は戦源に接続した本発明装置の一部の 概略的新面図であり、

第2図は本発明接触に関する電力転換効塞対 エレクトロルミネンセント 妻子効塞を示す対数 - 対数グラフである。 図中の各記号は下記のものを扱わす。

10:エレクトロルミネツセント装置:

12:陽板: 14:ガラス製支持体;

16:半透明被膜;

18:正孔インジェクション層: 20:発光層;

22: 脸框: 24:リードワイヤ:

26:遺跡。

芳許出願人 イーストマン・コダック・カンパニー

代理人并理士 湯 浅 恭 三层层层 (外4名)



